

ANMELDUNG PER FAX +49 (0)30.6392-3392

oder unter: www.berlin-widebase.de

15.09.2011

- Anmeldung zur Tagung
- Anmeldung zur Bootsfahrt

16.09.2011

Ich möchte an folgenden Führungen teilnehmen:

- IKZ – Kristallzüchtung
- FBH – Elektronik
- FBH – Epitaxie

Ich habe Interesse an Kooperationsgesprächen mit folgenden ‚Berlin WideBaSe‘-Partnern:

- AMT GmbH
- BeMiTec AG
- CrysTec GmbH
- eagleyard Photonics GmbH
- Jenoptik Polymer Systems GmbH
- LayTec AG
- OSA OPTO Light GmbH
- OSRAM GmbH, Display/Optic Development
- RTG Mikroanalyse GmbH
- Sentech Instruments GmbH
- Ferdinand-Braun-Institut, Leibniz-Institut für Höchstfrequenztechnik
- Leibniz-Institut für Kristallzüchtung
- Technische Universität Berlin

.....
Titel, Vorname, Name

.....
Firmenname für Rechnung

.....
Rechnungsanschrift

.....
Telefon Fax

.....
E-Mail

.....
Datum, Unterschrift

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Wann: 15. und 16. September 2011

Wo: pentahotel Berlin-Köpenick
Grünauer Straße 1, 12557 Berlin

Tagungsgebühren: 65 Euro

Anmeldung bis 26.08.2011

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Weitere Informationen unter:

www.berlin-widebase.de

Unterkunft: Bis 11.08.2011 steht ein begrenztes Kontingent an Zimmern im Tagungshotel zur Verfügung (+49 (0)30.65479-120). Bitte beziehen Sie sich bei der Buchung auf das Stichwort AK FER14092011.

ANSPRECHPARTNERIN

Britta Sommer
Geschäftsstelle ‚Berlin WideBaSe‘
Ferdinand-Braun-Institut, Leibniz-Institut für Höchstfrequenztechnik
Gustav-Kirchhoff-Straße 4
12489 Berlin

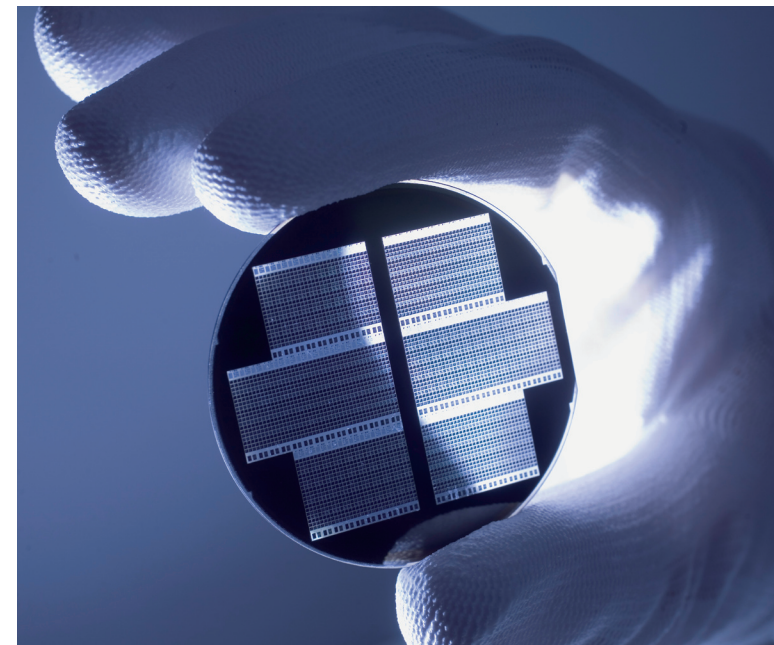
Telefon: +49 (0)30. 6392-3390

E-Mail: britta.sommer@fbh-berlin.de

PARTNER VON ‚BERLIN WIDEBASE‘



GEFÖRDERT VOM



Tagung

„Technologie und Anwendung von Nitrid-Halbleitern“

15. und 16. September 2011, Berlin

„TECHNOLOGIE UND ANWENDUNG VON NITRID-HALBLEITERN“

Am 15. und 16.09.2011 findet in Berlin die Tagung „Technologie und Anwendung von Nitrid-Halbleitern“ des Bündnisses ‚Berlin WideBaSe‘ statt. Experten aus Forschung und Industrie geben Einblicke in aktuelle und zukünftige Entwicklungen rund um Halbleiter mit großer Bandlücke (III-Nitride).

Ziel dieser Tagung ist es, den aktuellen Stand der Forschung an ausgewählten Anwendungsfeldern zu spiegeln und mit dem Fachpublikum Möglichkeiten und Chancen in der Entwicklung und Anwendung zu diskutieren. Abgerundet wird die Tagung mit der Möglichkeit zu Kooperationsgesprächen mit Partnern von ‚Berlin WideBaSe‘ sowie Führungen in den Forschungseinrichtungen.

Der vom Bundesministerium für Bildung und Forschung im Rahmenprogramm Unternehmen Region geförderte innovative regionale Wachstumskern ‚Berlin WideBaSe‘ besteht aus 10 Industrie- und 3 Forschungspartnern. Sie bündeln das in Berlin vorhandene Know-how und die technischen Ressourcen für die Entwicklung von optoelektronischen und elektronischen Bauelementen auf Basis von Nitrid-Halbleitern sowie deren Anwendung in unterschiedlichen Feldern entlang der gesamten Wertschöpfungskette.

Diese Tagung richtet sich ebenso an Anwender und potentielle Kunden wie auch an Forscher und Entwickler aus Unternehmen und Forschungseinrichtungen.

*Wir freuen uns,
Sie in Berlin begrüßen zu dürfen.*

PROGRAMM 15.09.2011

Ab 09:00 Uhr Anmeldung

10:00 Uhr	Begrüßung	Dr. Peter Rotsch , Sprecher ‚Berlin WideBaSe‘, OSA OPTO Light GmbH, Berlin
10:30 Uhr	„UV LEDs – Von der Materialforschung bis zum Bauelement“	Prof. Michael Kneissl , Technische Universität Berlin
11:00 Uhr	„Nutzen und Schaden der Einwirkung von UV-Strahlung auf die menschliche Haut“	Dr. Helmut Piazena , Charité Universitätsmedizin, Berlin
11:30 Uhr	„UV LEDs in Härtings- und Drucktechnik – Anforderungen, aktueller Stand und Perspektiven“	Petra Burger , Dr. Höhle AG, UV-Technologie, Gräfelfing
12:00 Uhr	„Anforderungen an Strahlungsquellen und die radiometrische Überwachung von UV-Desinfektionsgeräten für die Trinkwasserversorgung“	Oluf Hoyer , Wahnbach Wasser GmbH, Prüflabor für UV-Desinfektionsgeräte, Siegburg
12:30 – 13:30 Uhr Mittagspause		
13:30 Uhr	„Hocheffiziente Mikrowellen-Leistungsverstärker auf Basis von GaN“	Prof. Georg Böck , AMT GmbH, Berlin
14:00 Uhr	„AlGaIn/GaN High Electron Mobility Transistor based MMICs“	Prof. Herbert Zirath , Chalmers University of Technology, Göteborg
14:30 Uhr	„GaN-basierte Leistungselektronik in der Automobiltechnik“	Dr. Frederik Schrey , Robert Bosch GmbH, Gerlingen-Schillerhöhe
15:00 – 15:30 Uhr Kaffeepause		
15:30 Uhr	„AlN-Substrate – Bedeutung, Entwicklungsstand und Perspektive“	Dr. Boris Epelbaum , CrystAI-N GmbH, Erlangen
16:00 Uhr	„Group III-Nitrides: Research and Commercialization in Poland“	Prof. Michal Leszczynski , (Vizepräsident TopGaN) Polish Academy of Sciences, Institute of High Pressure Physics, Warschau
16:30 Uhr	Schlusswort	Dr. Peter Rotsch , Sprecher ‚Berlin WideBaSe‘
17:30 Uhr	Bootsfahrt	

PROGRAMM 16.09.2011

Führungen bei ‚Berlin WideBaSe‘-Partnern

Leibniz-Institut für Kristallzüchtung (IKZ):

„Einkristallzüchtung – von der Grundlagenforschung zur technologischen Reife“

Ferdinand-Braun-Institut, Leibniz-Institut für Höchstfrequenztechnik (FBH):

„GaN Hochleistungselektronik: Vom Chipdesign zum zuverlässigen Bauelement – ein Einblick in die Wertschöpfungskette“

Ferdinand-Braun-Institut, Leibniz-Institut für Höchstfrequenztechnik (FBH):

„Epitaxie von Nitrid-Heterostrukturen“

Kooperationsgespräche mit ‚Berlin WideBaSe‘-Partnern

Bitte geben Sie bei der Anmeldung Ihre Wünsche für Kooperationsgespräche an.